Misure

Errori 1

Incertezza Tipica: $\pm (\% lettura + \% fondo - scala)$

Strumento di classe x: lo strumento ha una precisione pari ad x\% del fondo-scala

Strumento di classe x: lo strumento ha una precisione pari ad x\% del fondo-scala
Errore Qualunque (Derivate Parziali):
$$y = f(x_1, x_2, ...) \rightarrow \delta y = \sum_i \left| \frac{\partial f(\vec{x})}{\partial x_i} \right|_{x = x_{mis}} \delta x_i$$

Errore Relativo: $y \text{ misura } \rightarrow \epsilon_r = \frac{\delta y}{y} \ (\epsilon_{r,\%} = 100 \cdot \epsilon_r)$

Somma/Differenza: $y = a \pm b \rightarrow \delta y = \delta a + \delta b$ gate

Prodotto/Divisione: $y = a \cdot b^{\pm 1} \rightarrow \epsilon_y = \epsilon_a + \epsilon_b$ Potenza/Radice: $y = x^{\pm n} \rightarrow \epsilon_y = n^{\pm 1} \epsilon_x$

2 Attrezzature

Errore di Lettura (Parallasse): valore di una "tacchetta"

Prodotto Banda Guadagno: $B \cdot t_{salita} = 0.35$ (varia col modello dell'oscilloscopio)

Relazione Salita-Visualizzato: $t_{s,visualizzato}^2 = t_{s,segnale}^2 + t_{s,circuito}^2 + t_{s,oscilloscopio}^2$

Solitamente il t_{so} è trascurabile.

Valor-Medio:
$$v_m = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} v(t)dt$$
 Valore Efficace: $v_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} v^2(t)dt}$

Duty-Cycle: $D = \frac{t_{alto}}{T}$

Sensibilità: (k_v) "altezza", solitamente in mV, di un "quadratino".

Lettura: V_{pp} del segnale, ottenuta come $k_v \cdot n_{div}$, n_{div} altezza del segnale in "quadratini"

Voltmetro a Doppia Rampa: $V_x = -\frac{T_2}{T_1}V_{rif}$ Incertezza di Quantizzazione: $\delta f_q = \frac{1}{T_{mis}}$

Frequenzimetro a Misura Diretta: $f_x = \frac{1}{t_x} = \frac{n}{T_c}$, $T_x = nT_c$ Risoluzione: $\delta f_x = \frac{1}{T_c}$ Risoluzione Relativa: $\frac{\delta f_x}{f_x} = \frac{1}{n}$

Scelta di T_1 : n(t) ruomore di periodo $T \to T_1 = T$ (spesso 50 Hz)

Riscaldamento di un Resistore: $T_{fin} - T_{amb} = R_{termica} \cdot P_{dissipata}$ Ponte di Wheatstone: All'equilibrio, la ddp ai due nodi centrali è nulla

Potenza $P = \frac{v_{eff}^2}{R}$, per segnali sinusoidali $v_{eff} = \frac{A}{\sqrt{2}}$

Costante Strumentale: $k_s = 1.11$ (semionda doppia) — $k_s = 2.22$ (semionda singola) Gli strumenti spesso riportano il valore efficace di un segnale. Questo valore è pari alla costante strumentale moltiplicata per valor medio del segnale.

! Nel calcolo del valor medio con voltmetro a semionda semplice della semionda semplice la parte negativa del segnale viene azzerata.

Condensatore in ingresso / Voltmetri TRMS: I voltmetri TRMS restituiscono la lettura reale del valore efficace di un segnale. Tuttavia vengono spesso accoppiati in AC (filtro sulla componente DC), riportando così il valore efficace del segnale originale traslato in basso del suo valor medio.

Onda Quadra: $v_{eff} = V_p$ per qualunque duty-cycle solo se le ampiezze sono simmetriche (es. -5V e 5V).

Elettronica

1 Segnali

Signal-to-Noise Ratio: $SNR = \frac{P_{segnale}}{P_{rumore}} = \frac{v^2}{n^2}$

SNR in dB: $SNR_{dB} = 10log_{10}(SNR) = 20log_{10}(\frac{v}{n})$

Errore di Quantizzazione: $\epsilon_q = \frac{S}{2^N + 1} = \frac{1}{2}LSB$, con S dinamica del segnale

2 Diodi

Polarizzazione Diretta: $v_D > 0, i_D \to \infty$, curva verticale per $v_D > V_\gamma \simeq 0.6 - 0.7~V$

Polarizzazione Inversa: $v_D < 0, i_D$ satura a valori piccoli e negativi (pA-fA)

Diodo Reale: $i_D = I_s(e^{\frac{v_D}{\eta V_T}} - 1)$

Diodo Ideale: $i_D > 0 \rightarrow v_D = 0, ON \mid v_D < 0 \rightarrow i_D = 0, OFF$ (nel circuito: generatore)

Diodo Semi-Ideale: $i_D > 0 \rightarrow v_D = V_{\gamma}, ON \mid v_D < V_{\gamma} \rightarrow i_D = 0, OFF$ (nel circuito: corto)

Resistenza di un Diodo (Piccolo Segnale): $g_D = \frac{1}{r_D} = \frac{I_D}{\eta V_T}$

3 Transistors

Corrente di Gate: $i_G=0$ in condizioni statiche per NMOS e PMOS. (BJT >0)

nMOS: v_{GS} , v_{DS} **pMOS:** v_{SG} , v_{SD}

"Trucco" Mnemonico: Il Source è sempre dov'è la corrente. Il Gate sempre la sbarra. Il Drain il rimanente. Per capire se usare v_{GS} o v_{SG} , bisogna posizionare due tensioni verso l'alto, una tra le due "gambe" del transistor (che sarà v_{DS} o v_{SD}) e una tra Gate e Source (che sarà v_{GS} o v_{SG}), ricordando che v_{XY} è una tensione con la punta in X e la coda in Y.

Condizioni Saturazione: $v_{GS/SG} > V_{TH}, \ v_{DS/SD} > v_{GS/SG} - V_{TH}$

Corrente di Drain (xMOS):

 $OFF \to i_D = 0 \mid ON \to i_D = \beta v_{DS} (v_{GS} - V_{TH} - \frac{v_{DS}}{2}) \mid SAT. \to i_D = \frac{\beta}{2} (v_{GS} - V_{TH})^2 (1 + \lambda v_{DS})$

Resistence: $g_m = \sqrt{2I_D\beta} = \beta(v_{GS} - v_{TH})$ $g_o = \lambda I_D$

4 Stadi Amplificatori

.

Tensione Ideale: $R_{in} \to \infty$, $R_{out} \to 0$ Corrente Ideale: $R_{in} \to 0$, $R_{out} \to \infty$

Transconduttanza: cioè $i_{out} = g_m v_{gs}$, ideale se $R_{in} \to \infty$, $R_{out} \to \infty$

Transresistenza: cioè $v_{out} = R_m i_s$, ideale se $R_{in} \to 0$, $R_{out} \to 0$

Efficienza Amplificatore Potenza: $\eta = \frac{P_{out}}{P_{al} + P_{in}} \simeq \frac{P_{out}}{P_{al}}$

Common Source: $A_v < 0, R_{in} \to \infty R_{out} = finita$

Common Drain: $A_v < 1$, $R_{in} \to \infty$ $R_{out} \simeq \frac{1}{q_m}$

Common Gate: $A_v \simeq g_m(R||r_o) \ R_{in} \simeq \frac{1}{g_m} \ R_{out} = R||r_o||r_o||$

Effetti di Carico: Uno stadio si comporta come un amplificatore con generatore pilotato.

Trovata R_{in} ed R_{out} , rappresenta il blocco centrale di un circuito di mezzo tra un generatore in ingresso v_{in} con resistenza R_S e un'uscita v_{out} con resistenza R_L . Si puo ricavare l'uscita v_{out} in funzione dell'ingresso v_{in} (e quindi la funzione di trasferimento $A_{v,s}$) eseguendo semplici partitori

Esempio: se lo stadio è un partitore di tensione, allora $v_{out} = v_{in} \frac{R_{in}}{R_{in} + R_S} A_v \frac{R_L}{R_L + R_{out}}$

5 Amplificatori Operazionali

.

Relazione Fondamentale (ideale): $v_d = 0 \rightarrow v^+ = v^- \quad i^+ = i^- = 0$

Amplificatore di Tensione: $A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1}, R_{in} \to \infty, R_{out} \to 0$

Amplificatore di Transconduttanza: $G_m = \frac{1}{R}$ (quella in retroazione), $R_{in} \to \infty$, $R_{out} \to \infty$

Amplificatore di Transresistenza: $R_m = R^{Il}$ (quella in retroazione), $R_{in} \to 0$, $R_{out} \to 0$

Amplificatore di Corrente: $A_i = 1 + \frac{R_2}{R_1}, R_{in} \to 0, R_{out} \to \infty$

Voltage-Follower: $v_{out} = v_{in}, R_{in} \to \infty, R_{out} \to 0$

Invertence: $A_v = -\frac{R_2}{R_1}, R_{in} = R_1, R_{out} \rightarrow 0$

Esponenziale: Diodo su R_1 Logaritmico: Diodo su R_2 Integratore: Condensatore su R_2

Derivatore: Condensatore su R_1 (Per tutti e 4: $R_{out} = 0$)

 $\textbf{Sommatore Generalizzato:} \ v_{out} = \frac{\sum_{i=0}^{M} G_{i^-} + G_f}{\sum_{i=0}^{N} G_{i^+}} \sum_{i=1}^{N} \frac{G_{i^+}}{G_f} v_{i^+} - \sum_{i=1}^{M} \frac{G_{i^-}}{G_f} v_{i^-}$

(Non usare questa formula, meglio sovrapposizione e/o Millman)

Common-Mode Rejection Ratio (CMRR): $\left| \frac{A_d}{A_{cm}} \right|$, $v_{cm} = \frac{v^+ + v^-}{2}$, $v_d = v^+ - v^-$

6 Limiti Amplificatori Operazionali

.

Circuito Eq. in Linearità: $v_{out} = A_d v_d + A_{cm} v_{cm} + A_{ps} v_{ps}$ Amplificazione Differenziale Finita: $A_v = \frac{\beta A_d}{1 + \beta A_d} \frac{1}{\beta} \to \frac{1}{\beta} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$ se $A_d \to \infty$ Banda Amplificazione: $B = \beta f_T$ Parametro Beta: $\beta = -\frac{v_d}{\hat{e}} = \frac{v_d}{A_d v_d + [\dots]_{eventual mente}}$

Offset di Tensione: V_{OFF} collegata al morsetto + Correnti di Polarizzazione: Corrente $I^+/I^- = I_{BIAS} + \frac{I_{OFF}}{2}$ ai due morsetti, uscente

$$I_{BIAS} = \frac{I^+ + I^-}{2}, \ I_{OFF} = I^+ + I^-$$

Comparatori

Ottenuti con retroazione positiva.

Soglie (Invertente): $V_{S1} = V_S \frac{R_2}{R_2 + R_1} + V_{OH} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$ $V_{S2} = V_{S1}$ ma con OL, V_S sul '+'

Soglie (Non Invertente): $V_{S1} = V_S(1 + \frac{R1}{R2}) - V_{OL}\frac{\bar{R1}}{R2}$, $V_{S2} = V_{S1}$ ma con OH, V_S sul '-' Comparatori Reali: $V_{S1/2,reale} = V_{S1/2,ideale} - V_{OFF}$

Oscillatori 8

da fare